

بررسی خواص حسگری رطوبت بر پایه چندسازه اکسیدگرافن/ دی سولفید

موليبدن

نفیسه توبه ئیها ^۱، نفیسه معماریان^{*۱} و فاطمه استواری^۲

۱-دانشکده فیزیک، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران ۲-دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیدہ:

نانومواد دوبعدی به دلیل ویژگیهایی همچون نسبت سطح به حجم بالا و جایگاههای فعال متعدد قابلیتهای ویژهای در حسگرهای گازی دارند. در این پژوهش، نانوصفحات دی سولفید مولیبدن، گرافن اکسید و کامپوزیت آنها، بترتیب با روش های لایه برداری مایع، هامرز و سونوشیمیایی تهیه شدند. ویژگیهای فیزیکی نانومواد تهیه شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی، پراش پرتو ایکس، طیف سنجی فروسرخ تبدیل فوریه و طیف سنجی رامان مورد بررسی قرار گرفت. سپس حسگر رطوبت بر پایه این مواد بر بستر Si/SiO₂ و با استفاده از الکترودهای اهمی (سیم رسانا) ساخته شد. بدلیل نوع متفاوت حامل ها در اکسید گرافن و دی سولفید مولیبدن (بترتیب نوع q و نوع n) نحوه تغییرات جریان در درصدهای مختلف رطوبت در این دو حسگر متفاوت بدست آمد و رفتار حسگر بر پایه چندسازه این دو ماده بیشتر به رفتار گرافن مشابه بود. زمان بازیابی و زمان پاسخدهی هر سه حسگر در محدوده ۲۰ ثانیه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که کامپوزیت اکسید گرافن و دی سولفید مولیبدن حسگری رطوبت

واژگان کلیدی: حسگر رطوبت، GO، MoS₂، چندسازه GO/MoS₂

*n.memarian@semnan.ac.ir

۱– مقدمه

رطوبت نسبی (RH) به دلیل اهمیت ویژه آن در بخشهای متفاوت زندگی ما بسیار مهم است [۱]. کنترل و اندازه گیری رطوبت نسبی برای بسیاری از برنامههای کاربردی مانند تشخیص رطوبت بدن انسان (HBR)، گرمایش، تهویه و سیستم های تهویه مطبوع در خانه ها سیستم های (HVAC) به کار برده می شود. همچنین در دفاتر، اتومبیل ها، مرطوب کنندهها،

موزه ها، فضاهای صنعتی و گلخانه ها استفاده می شوند و همچنین در ایستگاه های هواشناسی برای گزارش و پیش بینی آب و هوا استفاده می شوند. عملکرد سنجش رطوبت بر اساس پاسخ حسگر، حساسیت، پاسخ و زمان بازیابی، انتخاب، حد تشخیص، وضوح و ثبات تعیین میشود [۲]. مواد متفاوت برای سنجش رطوبت، از جمله بسپارها، سرامیک، چندسازه ها، نانولوله های کربنی و اکسیدهای فلزی استفاده می شود.

در دهههای اخیر، گرافن بهعنوان یک لایه اتمی از گرافیت، با ساختاری شامل اتمهای کربن با هیبریداسیون sp² در یک شبکه لانه زنبوری، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این ماده که در دسته نانومواد دوبعدی تک عنصری قرار دارد، بدلیل مساحت سطح ویژه زیاد، تحرکپذیری بالای حامل ها دارای خواص فوق العاده مكانيكي، الكتريكي و نوري است [3]. مشتقات اين ماده نیز می توانند در کنار خواصی که بدلیل ساختار اصلی دارند بگونهای مهندسی شوند که دارای ویژگیهای متفاوتی جهت کاربردهای متفاوت باشند. برای مثال اکسید گرافن دارای گروههای عاملی اکسیژنی است که بهصورت گروههای اپوکسی (C-)، كربونيل (OH-)، هيدروكسيل (-OH)، فنول (-C OH) و حتى گروههاى آلى سولفات به شبكه كربنى مسطح آن وارد می شوند [۴]. گرافن با عامل های اکسیژن دار دارای مزایای زيادى نسبت به گرافن خالص است، از جمله حلاليت بيشتر و واکنش پذیری بالاتر که فرصت های زیادی را برای استفاده در مواد نانوچندسازه ایجاد می کند [۵].

دسته بعدی، نانومواد دوبعدی شناخته شده از خانواده دی کالکوژن های فلزی با فرمول تعمیم یافته MX₂ هستند. در این مواد دو عنصری M فلز واسطه (Ta ،Nb ،V ،Hf ،Zr ، Ti، فلز واسطه (Ta ،Nb ،V ،Hf ،Zr ، Ti، S, اغلب X و (Co, Rh, Ir, Ni, Pd, Pt،Re ،Tc ،W ،Mo Se, Te است. این خانواده از نظر خواص الکتریکی می توانند رسانا، نیمرسانا و ابررسانا باشد. برای مثال دیسولفید مولیبدن (MoS₂) به دلیل تحرکپذیری به نسبت بالای حاملها، پایداری حرارتی بالا، خواص مغناطیسی توجه زیادی را به خود جلب کرده است [۶]. هان یانگ دانگ و همکارانش این ماده را بعنوان حسگر رطوبت بر اساس تشدید کننده موج آکوستیک سطحی مورد بررسی قرار دادند. آنها نشان دادند که این حسگر رطوبت دارای مزایایی از قبیل حساسیت بالا، پایداری بالا، پاسخ سریع (۰/۴ ثانیه) و زمان بازیابی کوتاه (۰/۸ ثانیه) است. بطوریکه می تواند تنفس انسان را ۱۰۰ بار در دقیقه و تشخیص غیر تماسی حرکت انگشتان را به خوبی نشان دهد[۷]. جینگ ژائو و همکاران در مطالعهای دیگر یک حسگر رطوبت یکپارچه را بر پایه MoS₂

تک لایه یکنواخت با مساحت سطح ویژه بزرگ گزارش کردند. در این نمونه تحرکپذیری حاملها در رطوبتهای ۰٪ تا ۳۵٪ به طور خطی کاهش یافت. همچنین،فرایند جذب فیزیکی آب منجر به زمان پاسخ دهی کوتاه شده بود [۸].

از طرفی ترکیب مواد دوبعدی از قبیل نانوصفحات اکسید گرافن (GO) و MoS₂ علاوه بر هزینه کمتر میتواند قابلیتهای هر دو نانو ماده را داشته باشد. این چندسازه به دلیل خواص منحصربهفرد و کاربردهای بالقوه زیادی که دارد، در ترانزیستورهای اثر میدانی (FET)، حسگرهای گاز، دستگاههای ذخیرهسازی انرژی و بعنوان کاتالیزور استفاده میشود. دباسری برمن و همکاران در پژوهشی حسگرهای رطوبت مقاومتی-شیمیایی مبتنی بر چندسازههای 2 GO/MoS بر روی بستر Si/SiO2 را مورد بررسی قرار دادند. آنها نمونههای متفاوت با درصدهای متفاوت تهیه و بهترین نمونه ساخته شده را مورد آزمایشات حسگری قرار دادند. در نهایت نمونه چندسازه بالا را نشان داد [۹]. جدول ۱ نتایج مقالات مرتبط با پژوهش صورت گرفته را نشان میدهد.

جدول ۱. نتایج مقالات مورد بررسی قرار گرفته

نمونه	حساسیت پذیری	زمان بازیابی (s)	زمان پاسخ دهی (s)	مرجع
rGO/MoS ₂	%95	۳۰/۸	۶/۳	[۱۰]
MoS ₂ /GO	٪۵۰	۳۷	۴۳	[٩]
rGO/MoS ₂	%۴٩	414	۱۷	[11]
GO	2371	+/174	۰/۰۲۵	[1٢]

در پژوهش حاضر، با توجه به مطالعات انجام گرفته برای اولین بار با استفاده از نانو مواد GO، MoS₂ و چندسازه GO/MoS₂ حسگرهای رطوبت با روش مقاومتی– الکتریکی مورد بررسی قرار گرفتند. برای این منظور ابتدا GO با استفاده از روش لایه برداری هامرز و نانو صفحات MoS₂ با استفاده از روش لایه برداری مایع آماده شدند. چندسازه GO/MoS₂ نیز به روش سونوشیمیایی تهیه شد. پس از مشخصهیابی مربوط به هر ماده،

پاسخ حسگری نمونهها در رطوبتهای متفاوت ۳۰٪ تا ۸۰٪ مورد بررسی قرار گرفته شد. علاوه بر این تکرارپذیری، زمان پاسخ و زمان بازیابی مورد بررسی قرار گرفت.

۲-۱- مواد و دستگاهها

در این پژوهش، همه مواد شیمیایی استفاده شده محصول شرکت مرک با خلوص بالای ۹۹٪ (analytical grade) است.

تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی به وسیله دستگاه TESCAN MIRA3 ساخت کشور چک انجام شد. آنالیز پراش پرتو ایکس با دستگاه Advance Bruker D-8 استفاده شد. با دستگاه Advance Bruker D-8 طیف سنجی رامان دستگاه Takram P50C0R10 طیف سنجی رامان انجام شد. همچنین طیف سنجی فوریه به وسیله دستگاه TTIR ساخت کشور آمریکا به ثبت رسید. تصاویر AVATAR ساخت کشور آمریکا به ثبت رسید. تصاویر میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) با دستگاه مدل -Veeco میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) با دستگاه مدل -Veeco اندازه گیری خواص حسگر گازی با استفاده از دستگاه V-I متر تولید شده شرکت راگا که دارای دقت اندازه گیری جریان از مرتبه نانوآمپر است، انجام گرفته است.

۲-۲- روش آزمایش

برای تهیه GO، ابتدا اکسید گرافیت به روش هامرز تهیه شد [۱۳]. به طوری که ابتدا ۲۰/۰۵م پودر اکسید گرافیت در ۷۵ میلیلیتر محلول آب و اتانول به نسبت ۵۵٪ به ۴۵٪ به مدت ۲ ساعت بر روی همزن مغناطیسی قرار داده شدند. بعد از آن محلول حاضر به مدت ۳ ساعت در حمام فراصوت قرار گرفت. محلول به دستآمده چندین بار با آب دیونیزه و اتانول شستشو داده شد. در نهایت پودر حاصل به مدت ۲۴ ساعت در دمای C[°] ۶۰ خشک شد.

برای تهیه صفحات MoS₂ نیز ۰/۰۵ گرم از پودر دی سولفید مولیبدن در ۲۵ میلی لیتر آب دیونیزه و اتانول به نسبت ۵۵٪ به ۴۵٪ به مدت ۴۵ دقیقه بر روی همزن مغناطیسی قرار داده شد.

سپس، به مدت ۴ ساعت در حمام فراصوت قرار گرفت. بعد از آن محلول به دست آمده با سرعت ۱۵۰۰ *rpm* به مدت ۱۵ دقیقه گریزانه شد و در آخر پودر حاصل به مدت ۱۸ ساعت در دمای ۲°۰۷ در آون خشک شد.

برای ساخت چندسازه GO/MoS₂ ، ۵۰/۰ گرم از اکسید گرافن با همین مقدار از دی سولفید مولیبدن تهیه شده، در ۷۵ میلی لیتر از ترکیب آب دیونیزه و اتانول پراکنده و به مدت ۴ ساعت در حمام فراصوت قرار گرفت. در نهایت، محلول بدست آمده به مدت ۲۴ ساعت در دمای C ک^o ۲۰ خشک شد.

به منظور بررسی خاصیت حسگری از نمونههای GO، MoS2 و GO/MoS2، ابتدا مواد ساخته شده به روش غوطهوری بر روی زیرلایه سیلیکونی لایه نشانی شد. سپس در گوشههای قطعه سیلیکونی الکترودهای اهمی (سیم رسانا) به کمک چسب نقره قرار گرفتند. طرحواره انجام آزمایش حسگر گازی در شکل ۱ نشان داده شده است.



شکل ۱. طرحواره دستگاه حسگر گازی مورد استفاده

٣- نتايج و بحث:

تصاویر FESEM از نمونههای GO، MoS₂ و GO/MoS به ترتیب در شکل ۲ (الف)، (ب) و (ج) نشان داده شده است.



شكل ۲. تصاویر FESEM، الف) صفحات تک لایه و چند لایه GO، ب) صفحات چندلایهای MoS₂/GO و ج) چندسازه MoS₂/GO

تصاویر FESEM ساختار لایهای از نانوصفحات GO و GO و MoS₂ که از طریق فراصوت لایه برداری شده اند، را نشان میدهند. همچنین، شکل ج نانو صفحات چندسازه GO/MoS₂ را نشان میدهد که از روش سونو شیمیایی تهیه شده است. در شکل۳ نمودار آنالیز طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس(EDS) نمونه چندسازه نشان داده شده است که حضور عناصر No، S، O و را نشان میدهد.



شکل۳. نمودار آنالیز EDS نمونه چندسازه GO/MoS₂

الگوهای پراش پرتو ایکس (XRD) هر سه نمونه در شکل ۴ نشان داده شده است. در جدول ۲ مشخصات قلهها و فاصله بین صفحات دو نمونه GO و MoS₂ گزارش شده است، که d به فاصله بین صفحات بلوری دلالت دارد و از قانون براگ بدست میآید [۱۴–۱۶].

مطالعه الگوی پراش XRD نمونههای MoS₂ و GO به ترتیب با شماره کارتهای ۱۴۹۲–۰۳۷ و ۱۴۸۷–۰۴۱ تطابق داشتند. همچنین برای نمونه چندسازه GO/MoS₂ شماره کارت استاندارد منطبق با نمونه MoS₂ بدست آمد. اندازه بلورکها با استفاده از معادله دبای شرر به صورت زیر محاسبه شد:

$D = K\lambda/\beta \cos\theta$

که در رابطه شرر، λ طول موج پرتو ایکس، K عدد ثابت برابر 0 زاویه پراش و β عرض پیک پراش در نصف بیشینه ارتفاع (FWHM) است. اندازه نانو ذرات GO، 0.6، نانومتر و XRD م 0.6 (GO/MOS محمد با توجه به داده های XRD و معادله دبای شرر، اندازه بلورک برای نمونه چندسازه GO/MoS و معادله دبای شرر، اندازه بلورک یرای نمونه چندسازه GO/MoS و معادله دبای شرر، اندازه بلورک ایرای نمونه چندسازه g GO/MoS و تمامی قلههای MoS و مربوط به مشاهده نشد. نمونه چندسازه، بیانگر قله 0.6 (MoS و تغییری در آن مشاهده نشد. نمونه چندسازه، بیانگر قله 0.6 (MoS و تغییری در آن مربوط به مشاهده نشد. نمونه چندسازه، بیانگر قله 0.6 (MoS و تغییری در آن مربوط به مرافده و تمامی قلههای MoS و تمامی قلههای در امتداد صفحه (۰۰۲)، در نمونه چندسازهی، تا حدی مهار می کند [۱۷]. از آنجا که در الگوی نمونه چندسازهی قله اضافه دیگری دیده نشده است و قلههای مربوط

به GO و MoS₂ جابجا نشدهاند می توان نتیجه گرفت که در طول فرایند فراصوت، ساختار بلوری هردو ماده حفظ می شود [۱۸].

نام مادہ	زاويه	شاخص صفحات	d (nm)
	١٠	•• \	۰/۸۳
GO	75	•••	•/٣٨
	14/37	••٢	•/87
MoS ₂	۳۲/۵	١	•/7۶
	۳٩/۵	1.7	•/٣٣
	۴٩/٧	١٠۵	•/١٩
	۵۸)).	٠/١۵



جدول ۲. نتایج XRD دو نمونه GO و MoS₂

شكل ۴. طيف XRD نمونه های GO، MoS₂ و چندسازه GO/MoS₂

شكل ۵، طيف رامان نمونه هاى GO، $^{2}MoS_{2}$ و چندسازه آنها را نشان مى دهد. قله هاى 1 m۴۵ cm⁻¹ و 1 ۱۵۸۷ مه ترتيب به قله D و قله G در GO مربوط هستند. قله D نشان دهنده نقص هاى ساختارى و خروج از حالت دوبعدى است و قله G نشان دهنده پيوندهاى كربنى درون صفحه در ساختار شش ضلعى است [۹۹]. قله رامان $^{2}MoS_{2}$ محلول در اتانول و آب در 1 ملعى است [۹۹]. قله رامان ^{2}Sm محلول در اتانول و آب در نسبت داده مى شود [۲۰]. قله هاى رامان نمونه چندسازه در 1 مى ۱۳۵۰cm⁻¹ به حالت فونون GV/Nos تشان دهنده وجود 1

چندلایهای MoS₂ است [۲۰]. در نمونه چندسازه GO/MoS₂ تغییر توزیع ابرالکترونی نانوصفحات GO به دلیل افزودن MoS₂ تغییر کرده است، که نشاندهنده افزایش عیوب ساختاری، مانند حضور اتم S بین لایههای گرافن است. بنابراین مکان قلههای D و G نسبت به نمونه GO جابجا می شود [۲۲, ۲۳].

شکل۶ طیف FTIR هر سه نمونه را نشان میدهد. قلههای ۱۳۸۲ -۱۳۸۶ گروههای کربوکسیل و اپوکسی را در نمونه GO نشان میدهند [۱۸].



شكل۵. طيف رامان نمونههای GO، MOS و نانوچندسازه GO/MOS

قله ¹-۲۶۲۳ به پیوند (C=O) در نمونه GO وابسته است [۲۵, ۲۵]. قلههای در محدوده ¹-۳۶۰۰cm گروه فنول (S-S). (C-OH) رانشان می دهند. قله ¹-۵۸ مربوط به پیوند (S-S) بیانگر مروح MoS₂ مربوط به پیوند (S-S) بیانگر MoS₂ مربوط به پیوند (S-S) پیوندهای (MoS₂) است [۲۵]. قله ¹-۱۸۷ در نمونه MoS₂ بیانگر پیوندهای (Mo-S) است [۲۵]. ارتعاشهای کششی (O-C) در قلههای ¹-۲۵۱۲۳ و ¹-۲۵۹ دیده می شوند، قلههای ¹-۲۳ قلههای ¹-۲۵۱۲۳ و (Mo-S) هستند (۲۶, ۲۶]. همچنین قله پیوندهای (Mo-S) و (Mo-O) هستند [۲۶, ۲۶]. همچنین قله پیوندهای (S-ON) و (Mo-O) هستند [۲۶, ۲۶]. همچنین قله ¹-۲۰۲۷ cm در نمونه چندسازه وابسته به پیوند (S-O) است که فقط در نمونه چندسازه مشاهده شد. قله ¹-۲۳ ۲۰۵ در نمونه چندسازه حاکی از پیوندهای (Mo-S) هستند. قله ¹-۲۳ ۵۰ در نمونه پیوند (S-O) در نمونه چندسازه مربوط است [۲۳]. قله پیوند (S-O) در نمونه چندسازه مربوط است [۲۳]. قله

زمستان ۱۴۰۲ | شماره۴ | سال دهم

بررسی FTIR چندسازه پیوند شیمیایی بین کربن، اکسیژن، گوگرد و مولیبدن را نشان می دهد [۱۷].



سطح نمونه نانوچندسازه GO/MoS₂ توسط آنالیز AFM بررسی شد. شکل ۷ الف تصویر AFM نانوچندسازه نشانده شده بر روی زیرلایه اکسید سیلیکون و مشخصات ارتفاع مربوطه را نشان می دهد. که نشان دهنده قرار گیری نانوصفحات MoS₂ در بین صفحات GO هستند. همچنین ضخامت لایهی چندسازهی تهیه صفحات GO هستند. همچنین ضخامت لایهی چندسازهی تهیه شده بر روی بستر سیلیکون توسط آنالیز تصویر AFM محاسبه شد. همان گونه که در شکل ۷ ب پروفایل سطح نشان داده شده است، ضخامت لایه قرار گرفته بر روی بستر SiO₂ ۵/۵





شکل ۲. الف) تصویر AFM و ب) پروفایل ارتفاع چندسازه GO/MoS₂ بر روی زیر لایه SiO₂

در ادامه پاسخ حسگری نمونهها در میزانهای متفاوت رطوبت محیط مطالعه شد. همه آزمایشها در دمای اتاق انجام شد. همچنین لازم به ذکر است که حسگر مقاومتی برای اولین بار حدود ۳۰ دقیقه در معرض هوا قرار گرفت تا به مقاومت پایه پایدار برسد. رسانایی لایه حسگر در حضور رطوبت تغییر میکند. برسد. رسانایی لایه حسگر در رطوبت های متفاوت با استفاده از آنالیز I-V اندازه گیری شد.



شکل۸. تغییرات جریان – ولتاژ در رطوبتهای متفاوت نسبت به رطوبت محیطی برای حسگر بر پایه الف) GO، ب) MoS₂ ج) یGO/MoS₂ ج

جهت بررسی تغییرات جریان در رطوبتهای متفاوت نسبت به رطوبت محیطی (۲۱٪) از رابطه ($I = I - I_0$) استفاده شد. در این رابطه I جریان الکتریکی گذرنده از حسگر در معرض درصد رطوبت خاص و I_0 جریان خوانده شده در حالت رطوبت پایه (۲۱٪) است. نتایج این اندازه گیری در شکل ۸ نشان داده شده است. حساسیت پذیری نمونه های تهیه شده با اندازه گیری جریان در رطوبتهای متفاوت در ولتاژ V۴ بررسی شد (شکل ۹). همچنین به منظور بررسی قابلیت تکرار پذیری حسگرها، تغییرات جریان با قطع و وصل کردن رطوبت، نسبت به زمان مورد بررسی قرار داده شد (شکل ۱۰).

همانطور که در شکل ۸ الف مشخص است، با افزایش رطوبت جریان گذرنده از حسگر بر پایه گرافن اکساید افزایش مییابد. افزایش جریان بدلیل افزایش چگالی حاملها اتفاق میافتد. از آنجا که گرافن تهیهشده به روش شیمیایی از نوع p است [۱۷]. هنگامی که این ماده در معرض رطوبت قرار می گیرد، مولکولهای آب از سر اکسیژندار خود به اتمهای کربن نزدیک شده و با توجه به خاصیت الکترون خواهی بالاتری که دارند، یک الکترون از سطح گرافن جدا کرده و یک حفره روی سطح باقی می گذارند. یونیزاسیون مولکول های آب به صورت زیر در نزدیکی سطح توسط پیوندهای قطبی رخ میدهد.

 $OH^{-}+2H_2O^{+} \Leftrightarrow H_3O$

سر منفی مولکول های OH⁻ در برهمکنش با هیدروژن موجود در هوا، آب را تولید می کند.

 $2OH^{-}+H_{2}\rightarrow 2H_{2}O$

سر مثبت آن با گروه هیدروکسیل روی سطوح برهمکنش داده و مولکول آب را به وجود می آورد.

$$H_3O^++OH^-\rightarrow 2H_2O^+$$

بنابراین، جذب مولکولهای آب روی سطح، با خروج الکترونها، چگالی حامل آن را تغییر میدهد. به این ترتیب چگالی حاملهای گرافن زیادتر و در نتیجه جریان عبوری از آن افزایش مییابد. این حفره میتواند مجددا با گازهای کاهنده موجود در محیط مثل

کربن منوکسید واکنش داده و مجددا گرافن به حالت اولیه بازگردد. هرچه درصد رطوبت بالاتر باشد، چگالی حاملها افزایش یافته و با توجه به تحرکپذیری بالا و مقاومت الکتریکی پایین در گرافن جریان الکتریکی افزایش مییابد [۲۸–۳۰].

شکل ۸ ب، نشانگر کاهش تغییرات جریان الکتریکی با افزایش رطوبت نسبی در حسگر بر پایه MoS₂ است. این ماده بدلیل حضور ناخالصیهای اکسیژندار از نوع n است [۳۱]. خارج کردن الکترونها از این نیمرسانای نوع n توسط مولکولهای آب باعث کاهش حاملهای بار و در نهایت کاهش جریان الکتریکی عبوری از این حسگر می شود.

نمودارهای تغییرات جریان حسگر رطوبت بر پایه چندسازه GO/MoS₂ در شکل ۸ ج نشان داده شده است. همانطور که در شکل پیداست افزایش رطوبت منجر به افزایش جریان در این حسگر می شود ولی حساسیت پذیری آن از حسگر بر پایه گرافن ضعیف تر است. در واقع حضور GO نوع q در کنار MoS₂ نوع n باعث می شود که مولکول های آب با جذب حامل های بار منفی در بعضی نقاط منجر به افزایش و در بعضی نقاط منجر به کاهش چگالی حامل های بار شوند. در واقع حضور دو نیمرسانا از دو نوع متفاوت در کنار یکدیگر باعث تضعیف خواص حسگری در برابر یک گاز می شود.



شکل۹. نمودار تغییرات جریان در رطوبتهای متفاوت در ولتاژ V^{*}



GO/MoS₂ و چندسازه MoS₂ و چندسازه GO/MoS₂ شکل ۱۰. پاسخ دهی نمونههای الف به رطوبتهای متفاوت۴۰ K۲٪ و۸۰ ۸۰٪

شکل ۹، نمودار تغییرات جریان بر حسب رطوبتهای متفاوت است. همان گونه که مشخص است با بالارفتن رطوبت و افزایش چگالی حاملها در حسگر بر پایه GO باعث افزایش جریان

زمستان ۱۴۰۲ | شماره۴ | سال دهم

عبوری نسبت به دو حسگر دیگر شده است که تائیدیست بر آنچه در بالا گفته شد.

پاسخ حسگرها به صورت I/I₀ نیز محاسبه شد و در شکل ۱۰ آورده شده است. به طور کلی پاسخ نمونه ها افزایش جریان (یعنی کاهش مقاومت) با افزایش رطوبت را در هر سه نمونه نشان داد.

از جمله ویژگیهای کلیدی برای هر حسگر علاوه بر کمیتهای کلیدی جهت بررسی کیفیت یک حسگر، حساسیتپذیری، زمان پاسخ و زمان بازیابی است. زمان پاسخ به عنوان زمان مورد نیاز برای رسیدن به ۸۰٪ تغییر جریان (ΔI) نهایی در حضور درصد مشخصی از رطوبت است. زمان بازیابی نیز به عنوان زمان مورد نیاز برای بازگشت به ۸۰٪ حالت اولیه پس از قطع رطوبت تعریف میشود [۳۲]. شکل ۱۱ نمودارهای زمان پاسخ و زمان بازیابی حسگرهای مورد بررسی را نشان میدهد.

حسگر بر پایه گرافن دارای پاسخ سریع (۲۰ ثانیه) به رطوبت، بهمراه زمان بازیابی کوتاه تنها ۲۰ ثانیه است (شکل ۱۱ الف). در GO زمان پاسخ و بازیابی عالی ناشی از فاصله بین لایه ای بزرگ بین صفحات با اندیس (۱۰۰) واقع در $7\theta=1^\circ$ است که جذب و دفع آب را در طول واکنش امکان پذیر می سازد [۳۳]. همچنین در MoS_2 فاصله بین لایه ای در صفحات با اندیس (۱۰۰۰) نیز زیاد بوده و خاصیت آبگریزی این ماده باعث جذب و دفع آب بر روی صفحات آن می شود [۳۴]. با این حال بازه زمانی پاسخ و زمان بازیابی MoS_2 از حسگر بر پایه گرافن بزرگ تر بازیابی به حسگر بر پایه چندسازه GO/MoS_2 زمان پاسخ و زمان بازیابی به حسگر بر پایه گرافن نزدیک تر است. بنابراین می توان بازیابی به حسگر بر پایه گرافن نزدیک تر است. بنابراین می توان



شکل۱۱. نمودارهای زمان پاسخ و زمان بازیابی نمونههای الف)GO، ب) GO/MoS₂ و ج) SO/MoS₂

humidity sensor based on saw resonator and mos 2 for human activity detection. 2021 IEEE 34th Conference on Micro Electro International Mechanical Systems (MEMS); 2021: IEEE.

Doi: 10.1109/MEMS51782.2021.9375370

Zhao J, Li N, Yu H, Wei Z, Liao M, Chen 8. P, et al. Highly sensitive MoS2 humidity sensors for noncontact sensation. Advanced arrav materials. 2017;29(34):1702076.

Doi: 10.1002/adma.201702076

Burman D, Ghosh R, Santra S, Guha PK. 9. Highly proton conducting MoS 2/graphene oxide nanocomposite based chemoresistive humidity sensor. Rsc Advances. 2016;6(62):57424-33.

Doi: 10.1039/C6RA11961A

10. Park SY, Kim YH, Lee SY, Sohn W, Lee JE, Shim Y-S, et al. Highly selective and sensitive chemoresistive humidity sensors based on rGO/MoS 2 van der Waals composites. Journal of Materials Chemistry A. 2018;6(12):5016-24.

Doi: 10.1039/C7TA11375G

Park SY, Lee JE, Kim YH, Kim JJ, Shim 11. Y-S, Kim SY, et al. Room temperature humidity sensors based on rGO/MoS2 hybrid composites synthesized by hydrothermal method. Sensors and Actuators B: Chemical. 2018;258:775-82.

Doi: 10.1016/j.snb.2017.11.176

12. Anichini C, Aliprandi A, Gali SM, Liscio F, Morandi V, Minoia A, et al. Ultrafast and highly sensitive chemically functionalized graphene oxide-based humidity sensors: harnessing device performances via the supramolecular approach. Applied Materials ACS & Interfaces 2020;12(39):44017-25.

Doi: 10.1021/acsami.0c11236

Joghataei M, Ostovari F, Atabakhsh S, 13. Tobeiha N. Heterogeneous ice nucleation by Graphene nanoparticles. Scientific Reports. 2020;10(1):9723.

Doi: 10.1038/s41598-020-66714-2

Zhao J, Li N, Yu H, Wei Z, Liao M, Chen 14. P, et al. Highly sensitive MoS2 humidity sensors array for noncontact sensation. Adv Mater. 2017;29(34):1702076.

Doi: 10.1002/adma.201702076

15. Ostovari F, Owji E, Iran HM. Humidity Sensor Based on Etched Optical Fibers Coated With Graphene Composite. 2021. Doi: 10.21203/rs.3.rs-558959/v1

۴- نتیجهگیری

در این پژوهش، حسگرهای رطوبت بر پایه MoS₂،GO و چندسازه GO/MoS₂ تهیه و پس از مشخصهیابی، خواص حسگری آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون های حسگری در رطوبتهای متفاوت نشان داد که زمان پاسخ و بازیابی نمونه چندسازه نسبت به دو نمونه دیگر کمتر است. حسگر بر پایه GO با حسگر بر پایه چندسازه قابلیت حسگری مشابهی داشت.

۵– مراجع:

Duan Z, Jiang Y, Tai H. Recent advances in 1. humidity sensors for human body related humidity detection. Journal of Materials Chemistry C. 2021;9(42):14963-80.

Doi:10.1039/D1TC04180K

Rajkumar K, Kumar RR. Gas sensors based 2. on two-dimensional materials and its mechanisms. Fundamentals and sensing applications of 2D materials: Elsevier; 2019. p. 205-58.

Doi:10.1016/B978-0-08-102577-2.00006-3

Sun L. Structure and synthesis of graphene 3. oxide. Chinese Journal of Chemical Engineering. 2019;27(10):2251-60.

Doi:10.1016/j.cjche.2019.05.003

Siaw W, Tsuji T, Manaf NA, Patah MA, 4. Jan BM, editors. Synthesis of graphene oxide from industrial waste. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering; 2020: IOP Publishing. Doi: 10.1088/1757-899X/778/1/012050

Smith AT, LaChance AM, Zeng S, Liu B, 5. Sun L. Synthesis, properties, and applications of graphene oxide/reduced graphene oxide and their nanocomposites. Nano Materials Science 2019;1(1):31-47.

Doi:10.1016/j.nanoms.2019.02.004

Thomas N, Mathew S, Nair KM, O'Dowd 6. K, Forouzandeh P, Goswami A, et al. 2D MoS2: mechanisms, photocatalytic structure, and applications. Materials Sustainability. Today 2021;13:100073.

Doi: 10.1016/j.mtsust.2021.100073

Dong H, Li D, Pang J, Zhang Q, Xie J, 7. editors. Highly sensitive and fast-response

Doi: 10.1016/j.electacta.2022.141781

24. Liu H, Chen X, Deng L, Su X, Guo K, Zhu Z. Preparation of ultrathin 2D MoS2/graphene heterostructure assembled foam-like structure with enhanced electrochemical performance for lithium-ion batteries. Electrochimica Acta. 2016;206:184-91.

Doi: 10.1016/j.electacta.2016.04.160

25. Owji E, Mokhtari H, Ostovari F, Darazereshki B, Shakiba N. 2D materials coated on etched optical fibers as humidity sensor. Scientific Reports. 2021;11(1):1771.

Doi: 10.1038/s41598-020-79563-w

26. Yang C, Wang Y, Wu Z, Zhang Z, Hu N, Peng C. Three-dimensional MoS2/reduced Graphene Oxide nanosheets/Graphene quantum dots hybrids for high-performance roomtemperature NO2 gas sensors. Nanomaterials. 2022;12(6):901.

Doi: 10.3390/nano12060901

27. Phan D-T, Chung G-S. P–n junction characteristics of graphene oxide and reduced graphene oxide on n-type Si (111). Journal of Physics and Chemistry of Solids. 2013;74(11):1509-14.

Doi: 10.1016/j.jpcs.2013.02.007

28. Ruiz V, Fernández I, Carrasco P, Cabañero G, Grande HJ, Herrán J. Graphene quantum dots as a novel sensing material for low-cost resistive and fast-response humidity sensors. Sensors and Actuators B: Chemical. 2015;218:73-7.

Doi: 10.1016/j.snb.2015.04.092

29. Sett A, Biswas K, Majumder S, Datta A, Bhattacharyya TK. Graphene and Its Nanocomposites Based Humidity Sensors: Recent Trends and Challenges: IntechOpen; 2021.

Doi: 10.5772/intechopen.98185

30. Wang P, Wang X, Tan F, Zhang R. Residual Oxygen Effects on the Properties of MoS2 Thin Films Deposited at Different Temperatures by Magnetron Sputtering. Crystals. 2021;11(10):1183.

Doi: 10.3390/cryst11101183

31. Saqib M, Ali Khan S, Mutee Ur Rehman HM, Yang Y, Kim S, Rehman MM, et al. Highperformance humidity sensor based on the graphene flower/zinc oxide composite. Nanomaterials. 2021;11(1):242. Doi: 10.3390/nano11010242 16. Li Y, Fan K, Ban H, Yang M. Detection of very low humidity using polyelectrolyte/graphene bilayer humidity sensors. Sensors and Actuators B: Chemical. 2016;222:151-8.

Doi: 10.1016/j.snb.2015.08.052

17. Sarwar S, Karamat S, Bhatti AS, Aydinol MK, Oral A, Hassan MU. Synthesis of Graphene-MoS2 composite based anode from oxides and their electrochemical behavior. Chemical Physics Letters. 2021;781:138969.

Doi: 10.1016/j.cplett.2021.138969

18. Murugan M, Kumar MR, Alsalme A, Alghamdi A, Jayavel R. Synthesis and property studies of molybdenum disulfide modified reduced graphene oxide (MoS2-rGO) nanocomposites for supercapacitor applications. Journal of Nanoscience and Nanotechnology. 2017;17(8):5469-74.

Doi: 10.1166/jnn.2017.13845

19. Sarma S, Mbule P, Ray SC. Layer-by-layer MoS2: GO composite thin films for optoelectronics device applications. Applied Surface Science. 2019;479:1118-23.

Doi: 10.1016/j.apsusc.2019.02.165

20. Yadav S, Chaudhary P, Uttam K, Varma A, Vashistha M, Yadav B. Facile synthesis of molybdenum disulfide (MoS2) quantum dots and its application in humidity sensing. Nanotechnology. 2019;30(29):295501.

Doi: 10.1088/1361-6528/ab1569

21. Thangappan R, Kalaiselvam S, Elayaperumal A, Jayavel R, Arivanandhan M, Karthikeyan R, et al. Graphene decorated with MoS 2 nanosheets: a synergetic energy storage composite electrode for supercapacitor applications. Dalton transactions. 2016;45(6):2637-46.

Doi: 10.1039/C5DT04832J

22. Ding X, Huang Y, Li S, Zhang N, Wang J. 3D architecture reduced graphene oxide-MoS2 composite: preparation and excellent electromagnetic wave absorption performance. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. 2016;90:424-32.

Doi: 10.1016/j.compositesa.2016.08.006

23. Fioravanti F, Martínez S, Delgado S, García G, Rodriguez JL, Tejera EP, et al. Effect of MoS2 in doped-reduced graphene oxide composites. Enhanced electrocatalysis for HER. Electrochimica Acta. 2023;441:141781.

32. Rathi K, Pal K. Impact of doping on GO: Fast response–recovery humidity sensor. ACS omega. 2017;2(3):842-51.

Doi: 10.1021/acsomega.6b00399

33. Meng W, Wu S, Wang X, Zhang D. Highsensitivity resistive humidity sensor based on graphitic carbon nitride nanosheets and its application. Sensors and Actuators B: Chemical. 2020;315:128058.

Doi: 10.1016/j.snb.2020.128058

Investigation of humidity sensing properties based on graphene oxide/molybdenum disulfide composite

N. Tobeiha¹, N. Memarian^{1,*} and F.Ostovari²

1. Faculty of Physics, Semnan University, Semnan, Iran 2.Department of Physics, Faculty of Science, Yazd University, Yazd, Iran

Abstract:

Two-dimensional nanomaterials have special capabilities in gas sensors due to features such as high surface-tovolume ratio and multiple active sites. In this research, molybdenum disulfide nanosheets, graphene oxide and their composites were prepared by liquid exfoliation, Hammers, and sonochemical methods, respectively. Physical properties of the prepared nanomaterials were evaluated using scanning electron microscopy, X-ray diffraction, Fourier transform infrared spectroscopy, and Raman spectroscopy. Then the humidity sensors were prepared based on these materials on Si/SiO₂ substrates and using copper electrodes. Due to the different types of carriers in graphene oxide and molybdenum disulfide (p-type and n-type, respectively), the current changes in different moisture percentages were obtained differently for these two sensors, and the behavior of the sensor based on the composite of these two materials was more similar to the behavior of graphene. The recovery time and response time of all three sensors were measured within 20 seconds. The results showed that the composite of graphene oxide and molybdenum disulfide, has a better humidity sensor behaviour rather than molybdenum disulfide nanosheets.

Keywords: Humidity Sensors, GO, MoS₂, GO/MoS₂ Composite.